



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۸۴۵۳-۲

چاپ اول

۱۳۹۴

INSO

8453-2

1st.Edition

2016

کارت‌های شناسایی - روش‌های آزمون  
قسمت ۲:  
کارت‌های دارای نوار مغناطیسی

Identification cards - Test methods -  
Part 2:  
Cards with magnetic stripes

ICS:35.240.15

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### « کارت‌های شناسایی - روش‌های آزمون - قسمت ۲: کارت‌های دارای نوار مغناطیسی »

#### رئیس:

قیصری اردهایی، تقی  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

#### سمت و / یا نمایندگی

شرکت سرمد تبریز

#### دبیر:

جاودانی، بهاره  
(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شرکت معیار آزمای ارس

#### اعضاء:

اعتماد، جواد  
(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت الکاپرداز

بدرزاده، فریبا  
(کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

بدلی افشرد، بابک  
(کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

بهریگی، مهدی  
(کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

مدیر پروژه کارت سوخت

ترکمن، لیلا  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

ترکمن، آزاده  
(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت توزیع برق استان قزوین

رضایی، سعید  
(کارشناسی مهندسی صنایع)

شرکت تسکو

عجمی، علی  
(دکتری مهندسی برق)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شرکت مبتکران بهینه نیروی آذربایجان

فلاح اردشیر، جابر  
(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شرکت آفتارکان

نصرتی، مهران  
(کارشناسی مهندسی صنایع)

شرکت مبتکران بهینه نیروی آذربایجان

نظری، یوسف  
(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شرکت مبتکران بهینه نیروی آذربایجان

نیکجو، نوید  
(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت مبتکران بهینه نیروی آذربایجان

وارثی، کاظم  
(کارشناسی ارشد مهندسی برق)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش‌گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد ۱
۱	مراجع الزامی ۲
۲	اصطلاحات و تعاریف ۳
۷	موارد پیش‌فرض قابل کاربرد برای روش‌های آزمون ۴
۷	محیط آزمون ۱-۴
۷	پیش‌شرایط‌دهی ۲-۴
۷	انتخاب روش‌های آزمون ۳-۴
۷	رواداری پیش‌فرض ۴-۴
۷	عدم قطعیت کلی اندازه‌گیری ۵-۴
۷	روش‌های آزمون ۵
۷	تاب‌برداشتن منطقه نوار مغناطیسی ۱-۵
۹	ارتفاع و پروفیل سطح نوار مغناطیسی ۲-۵
۱۴	زبری سطح نوار مغناطیسی ۳-۵
۱۴	آزمون سایش برای نوار مغناطیسی ۴-۵
۱۶	اندازه‌گیری‌های دامنه ۵-۵
۲۴	تغییر فاصله گذار شار ۶-۵
۲۵	چسبندگی نوار مغناطیسی ۷-۵
۲۷	مشخصه‌های مغناطیسی استاتیکی ۸-۵
۳۰	شکل موج $U_{i6}$ ۹-۵
۳۱	وادارندگی بالا، اضافه‌نویسی تراکم بالا ۱۰-۵
۳۲	پیوست الف(اطلاعاتی)، اثر سایش بر روی سرهای آزمون و استفاده از سرهای آزمون مقاوم به سایش

## پیش گفتار

استاندارد "کارت‌های شناسایی- روش‌های آزمون- قسمت ۲: کارت‌های دارای نوار مغناطیسی" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است و در چهارصد و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات مورخ ۹۴/۱۲/۰۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مآخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ISO/IEC 10373-2: 2015, Identification cards - Test methods - Part 2: Cards with magnetic stripes

## کارت‌های شناسایی - روش‌های آزمون - قسمت ۲: کارت‌های دارای نوار مغناطیسی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون برای مشخصات کارت‌های شناسایی، مطابق با تعریف استاندارد ایران ایزو آی‌ای سی ۷۸۱۰ است. هر روش آزمون متقابلاً به یک یا چند استاندارد پایه، برای مثال استاندارد ایران ایزو آی‌ای سی ۷۸۱۰، یا استانداردهای تکمیلی که فناوری ذخیره‌سازی اطلاعات در کاربردهای کارت شناسایی را تعریف می‌کند، اشاره دارد.

این استاندارد، روش‌های آزمون ویژه فناوری نوار مغناطیسی را تعریف می‌کند.

**یادآوری ۱** - این استاندارد شامل معیارهای پذیرش نیست اما در استانداردهای ذکر شده در بالا این معیارها یافته می‌شود.

**یادآوری ۲** - روش‌های آزمون توصیف شده در این استاندارد برای این که به طور جداگانه انجام شود در نظر گرفته شده است. برای یک کارت نیاز به عبور از تمام آزمون‌ها به ترتیب نمی‌باشد.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۲۲: مشخصات هندسی محصول-(GPS)نمایش بافت سطحی در مستندسازی فنی محصول

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۰۵: پوشش‌ها و جلاها -آزمون چسبندگی به روش برش متقاطع

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۸: ویژگی‌های هندسی محصول - (GPS) بافت سطح: روش نیم‌رخ - مشخصه‌های اسمی دستگاه‌های اندازه‌گیری تماسی (سوزنی)

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۲۸: ویژگی های هندسی فرآورده - (GPS) بافت سطح : روش نمایه - قواعد و روش های اجرایی برای ارزیابی بافت سطح

۵-۲ استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۷۸۱۰: کارت های شناسایی - مشخصه های فیزیکی

۶-۲ استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۷۸۱۱-۲: کارت های شناسایی - فن ضبط - قسمت ۲: نوار مغناطیسی - پسماند مغناطیسی کم

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۵۶-۸: کارت های شناسایی - فن ضبط - قسمت ۸: نوار مغناطیسی - شدت میدان مورد نیاز برای مغناطیس زدایی ۷/۵۱ کیلوآمپر بر متر ۶۵۰ (Oe)

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۸۰-۲: نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی - قسمت ۲: روش های آزمون

**2-9 ISO/IEC 7811-6, Identification cards - Recording technique - Part 6: Magnetic stripe - High coercivity**

**2-10 ISO/IEC 7811-7, Identification cards - Recording technique - Part 7: Magnetic stripe - High coercivity, high density**

**2-11 ISO/IEC 8484, Information technology - Magnetic stripes on savingsbooks**

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود.

یادآوری - برای تعاریف مشخصه های مغناطیسی استاتیکی به استانداردهای IEC 60050-221 و IEC 80000-6 رجوع شود.

۱-۳

#### روش آزمون

##### test method

روشی برای آزمون مشخصه های کارت های شناسایی، به منظور تایید انطباق آنها با استانداردهای بین المللی

۲-۳

#### آزمون پذیری کارکردی

##### testably functional

عدم آسیب در برابر نفوذ آثار بالقوه مخرب به گونه ای که:

الف - هریک از نوارهای مغناطیسی موجود بر روی کارت، رابطه ای بین دامنه های سیگنال قبل و پس از آزمون، که در انطباق با استاندارد پایه است، را نشان دهد.



ب- مدار(های) مجتمع موجود در کارت، به نشان دادن پاسخ به تنظیم مجدد<sup>۱</sup> که مطابق با استاندارد پایه است، ادامه دهد.

پ- هراتصال مرتبط با مدار(های) مجتمع موجود در کارت، به نشان دادن مقاومت و امپدانس که مطابق با استاندارد پایه است، ادامه دهد.

ت- هر حافظه نوری موجود در کارت، به نشان دادن ویژگی‌های نوری که مطابق با استاندارد پایه است، ادامه دهد.  
ث- مدار(های) مجتمع فاقد اتصالات در کارت، به عملکرد مطلوب خود ادامه دهد.

۳-۳

تاب برداشتن

**warpage**

انحراف از تختی

۴-۳

انتقال شار بر میلی‌متر، ft/mm

**flux transitions per millimetre**

تراکم ضبط خطی اعمال شده به شیار<sup>۲</sup> در یک نوار مغناطیسی

۵-۳

ضبط

**recording**

ایجاد یک شیار برگشت شار منطبق با روش آزمون ارائه شده در این استاندارد، با مقادیر تمام پارامترهای آزمون کاربردی تعیین شده

۶-۳

کدگذاری

**encoding**

ایجاد یک شیار برگشت شار با فاصله اصلاح شده، طبق یک شمای برنامه نویسی، برای ارائه داده

۷-۳

زبری سطح

---

۱- این استاندارد هیچ آزمونی را برای ایجاد عملکرد کامل مدار(های) مجتمع تعریف نمی‌کند. روش‌های آزمون تنها نیازمند این است که حداقل قابلیت اجرایی (کاربرد آزمایشی) تأیید شود. این می‌تواند در شرایط مناسب، توسط معیارهای اجرایی کاربرد- خاصی که در حالت کلی در دسترس نیست تکمیل شود.

### surface roughness

توپولوژی سطح یک ناحیه از سطح، تاییدشده در استانداردهای بین‌المللی با ارجاع به تفکیک‌پذیری‌های تعیین‌شدهٔ مختلف و روش‌های محاسبه

۸-۳

اندازه‌گیری‌های دامنه

### amplitude measurements

(نوار مغناطیسی) اندازه‌گیری دامنه سیگنال بازخواندنی<sup>۱</sup> با توجه به روش آزمون ارائه‌شده در این استاندارد، با مقادیر تمام پارامترهای آزمون کاربردی تعیین‌شده

۹-۳

انحراف از فاصلهٔ گذار شار

### flux transition spacing variation

انحراف از مقادیر نامی اندازه‌گیری‌شدهٔ فاصله بین گذار شار مجاور در امتداد یک خط موازی با خط مرکزی در مسیر کدگذاری شده

۱۰-۳

چسبندگی نوار مغناطیسی

### magnetic stripe adhesion

استحکام چسب بین نوار مغناطیسی و کارت

۱۱-۳

استفاده عادی

### normal use

استفاده به عنوان کارت شناسایی مطابق با استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۷۸۱۰، که شامل فرآیندهای تجهیزات مناسب با ذخیره‌سازی و فناوری کارت به عنوان یک مدرک شخصی بین فرآیندهای تجهیزات است

۱۲-۳

حلقه  $M(H)$  اشباع استاتیکی

### static saturation M(H) loop

حلقه پسماند عادی، که در آن شدت میدان مغناطیسی بین مقادیر حدی  $H_{max}$  و  $+H_{max}$  نوسان می‌کند، در چنان نرخ تغییرات پایینی که حلقه تحت تاثیر این نرخ تغییر قرار نمی‌گیرد

۱۳-۳

و ادا رندگی،  $H'_{cM} = H'_{cJ}$

**Coercivity,  $H'_{cM} = H'_{cJ}$**

میدان مغناطیسی اعمال شونده پیوسته که با محور طولی نوار اندازه گیری شده موازی است و باعث کاهش خاصیت مغناطیسی از مقدار اشباع شده قبلی به مقدار صفر در جهت خلاف می شود

۱۴-۳

و ادا رندگی پسماند،  $H_r$

**remanent coercivity,  $H_r$**

میدان مغناطیسی اندازه گیری شده که با محور طولی نوار اندازه گیری شده موازی است و به هنگام حذف، مواد را از حالت اشباع شده قبل به حالت صفر مغناطیسی در جهت عکس برمی گرداند

۱۵-۳

اُرسِتِد، Oe

**Oersted, Oe**

واحد گاوسی CGS شدت میدان مغناطیسی که معمولاً در صنعت ضبط مغناطیسی استفاده می شود و تقریباً معادل ۷۹,۵۷۸ A/m است.

۱۶-۳

مغناطیس زدایی استاتیکی،  $S_{160}$

**static demagnetization,  $S_{160}$**

کاهش در مغناطیس شونددگی، تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی مخالف؛ که با  $[M_r - M^+(-160)] \div M_r$  مشخص می شود، شیب متوسط "مغناطیس زدایی" ربعی از حلقه اشباع استاتیکی  $M(H)$  بین مقادیر شدت میدان مغناطیسی از  $H = 0$  و  $H = -160$  kA/m است.

۱۷-۳

مجذور، SQ

**Squareness, SQ**

نسبت  $M_r$ ، مقدار مغناطیس‌شوندگی ( $M$ ) در شدت میدان مغناطیسی صفر ( $H=0$ )، به  $M(H_{max})$  مقدار مغناطیس‌شوندگی در  $H_{max}$  به دست‌آمده از حلقه اشباع استاتیکی  $M(H)$

۱۸-۳

مجذور طولی،  $SQ_{\parallel}$

longitudinal squareness,  $SQ_{\parallel}$

مجذور مقدار متوسط اندازه‌گیری شده موازی با محور طولی نوار مغناطیسی

۱۹-۳

مجذور عمودی،  $SQ_{\perp}$

perpendicular squareness,  $SQ_{\perp}$

مجذور مقدار متوسط اندازه‌گیری شده عمود بر سطح نوار مغناطیسی

۲۰-۳

میدان راه‌اندازی به‌وسیله مشتقات،  $SF_D$

switching field by derivative,  $SF_D$

عرض نیم‌ارتفاع منحنی مغناطیس‌شوندگی استاتیکی  $M(H)$  تقسیم بر وادارندگی همان منحنی

۲۱-۳

میدان راه‌اندازی به‌وسیله شیب،  $SF_S$

switching field by slope,  $SF_S$

اختلاف بین مقادیر میدان در نقطه قطع حلقه مغناطیس‌شوندگی استاتیکی  $M(H)$ ،  $M(H)$  برای  $M_r \cdot 0.5$  و  $M(H)$

برای  $M_r \cdot 0.5$ ، تقسیم بر وادارندگی

۲۲-۳

حداکثر زاویه مجذور،  $\theta(SQ_{max})$

angle of maximum squareness,  $\theta(SQ_{max})$

زاویه بین محور طولی نوار مغناطیسی و جهتی که در آن حداکثر مقدار مجذور قابل دستیابی است

۲۳-۳

تفکیک‌پذیری

resolution

مقدار متوسط دامنه سیگنال در یک تراکم ضبط بالاتر تقسیم بر مقدار متوسط دامنه سیگنال در تراکم ضبط پایین تر مشخصی، ضرب در ۱۰۰ و بیان به صورت درصد

۲۴-۳

$U_{Fi}$

مقدار المان اختصاصی در یک فرکانس مشخص از طیف فوریه کل شکل موج نوار

#### ۴ موارد پیش فرض قابل کاربرد برای روش های آزمون

##### ۱-۴ محیط آزمون

به غیر از موارد مشخص شده دیگر، آزمون باید در محیط با دمای  $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$ ) رطوبت نسبی ۴۰٪ تا ۶۰٪ انجام شود.

##### ۲-۴ پیش شرایطدهی

زمانی که برای روش آزمون پیش شرایطدهی مورد نیاز است، کارت های شناسایی برای این که مورد آزمون قرار گیرند باید ۲۴ ساعت قبل از آزمون در محیط آزمون قرار گیرند.

##### ۳-۴ انتخاب روش های آزمون

آزمون ها برای سنجیدن ویژگی های کارت مطابق با استاندارد پایه مربوط، باید انجام شوند.

##### ۴-۴ رواداری پیش فرض

به غیر از موارد مشخص شده دیگر، باید یک رواداری پیش فرض  $\pm 5\%$  به مقادیر کمی مفروض برای مشخص کردن ویژگی های تجهیزات آزمون (به عنوان مثال ابعاد خطی) و مراحل روش آزمون (برای مثال تنظیم تجهیزات آزمون)، اعمال شود.

##### ۵-۴ عدم قطعیت کلی اندازه گیری

عدم قطعیت کلی اندازه گیری برای هر کمیت تعیین شده توسط این روش های آزمون باید در گزارش آزمون ذکر شود.

#### ۵ روش های آزمون

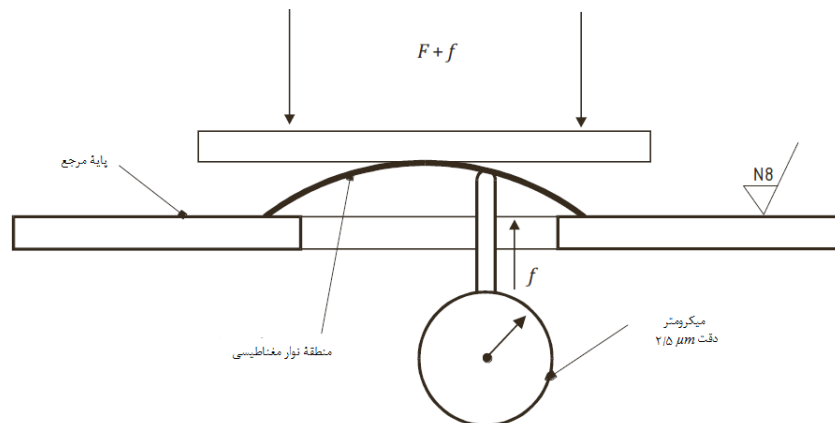
##### ۱-۵ تاب برداشتن منطقه نوار مغناطیسی

هدف از انجام این آزمون اندازه‌گیری درجه تاب برداشتن یک کارت نمونه آزمون در منطقه نوار مغناطیسی است (به استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۲-۷۸۱۱، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO / IEC7811-6، ISO / IEC7811-7، ISO / IEC8484 رجوع شود). روش آزمون برای هر دو نوع کارت برجسته و غیر برجسته قابل کاربرد است.

### ۵-۱-۱ دستگاه

دستگاه در شکل ۱ نشان داده شده است و شامل موارد زیر است:

- الف- صفحه صلب که زبری سطح آن در انطباق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۲۲ کوچکتر یا مساوی  $3.2 \mu\text{m}$  است. صفحه باید دارای شکافی باشد که امکان دسترسی به پراب میکرومتر را بدهد.
- ب- شاخص نشانگر با درستی در حدود  $2.5 \mu\text{m}$  با پرابی که ناحیه اتصال آن یک نیمکره با قطری در گستره  $3 \text{ mm}$  تا  $8 \text{ mm}$  است. نیروی اعمالی توسط پراب باید  $f = 0.3 \text{ N} \pm 0.6 \text{ N}$  باشد.
- پ- وسیله اعمال نیروی یکنواخت  $f = 2.2 \text{ N}$  که بر رویه جلویی کارت در جهت عکس ناحیه نوار مغناطیسی توزیع شده است.



شکل ۱ - چیدمان اندازه‌گیری (بدون مقیاس)

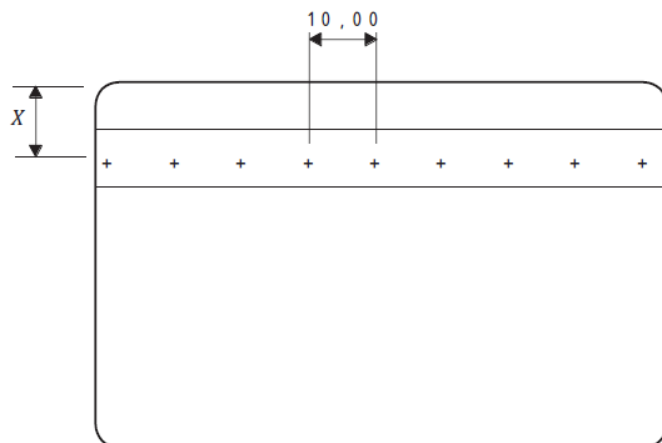
### ۵-۱-۲ روش انجام

کارت نمونه را به نحوی که رویه جلویی به سمت بالا باشد، روی سطح صفحه صلب قرار دهید. ناحیه نوار مغناطیسی را برای اندازه‌گیری از طریق شکاف قرار دهید.

بار  $f = 2.2 \text{ N}$  باید توسط نیروی  $f$  به حدی افزایش یابد که نیروی میکرومتر را که در جهت عکس عمل می‌کند خنثی کند.

نیروی  $F+f$  را مستقیماً روی ناحیه نوار مغناطیسی در طرف جلوی کارت اعمال کنید. قبل از هرگونه اندازه‌گیری ۱ دقیقه صبر کنید.

تاب ناحیه نوار کارت را در نه موقعیت در امتداد نوار مطابق شکل ۲، اندازه‌گیری کنید. در صورتی که تاب ناحیه نوار در آن مناطق بیشتر از نه ناحیه تعیین شده باشد، موقعیت‌های دیگری نیز باید اندازه‌گیری شوند.



یادآوری - مقادیر X در جدول ۱ آورده شده است.

شکل ۲ - نقاط اندازه‌گیری بر روی کارت (ابعاد برحسب میلیمتر، بدون مقیاس)

جدول ۱ - موقعیت خط نقاط اندازه‌گیری

ابعاد X (mm)	ناحیه نوار مغناطیسی
۸,۰۰	شماره‌های ۱ و ۲
۱۰,۷۰	شماره‌های ۱، ۲ و ۳

### ۳-۱-۵ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداکثر مقدار به دست آمده از مجموع نه اندازه‌گیری را بدهد.

### ۲-۵ ارتفاع و پروفیل سطح نوار مغناطیسی

هدف از انجام این آزمون تعیین ارتفاع و تختی نوار مغناطیسی یک کارت آزمون نمونه است (به استاندارد ایران ایزو آی‌ای‌سی ۲-۷۸۱۱، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO/IEC7811-6، ISO/IEC7811-7، ISO/IEC8484 رجوع شود).

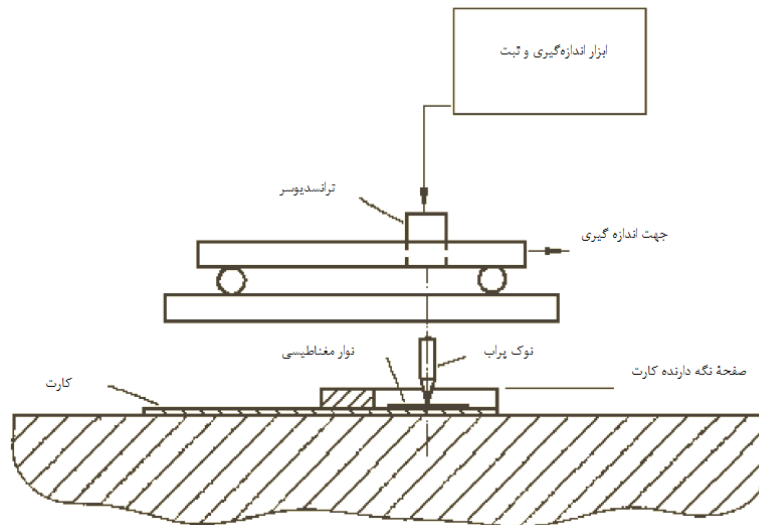
ارتفاع نوار مغناطیسی با ارجاع به کارت و مقطع سطح نوار تعیین می‌شود.

### ۱-۲-۵ وسایل

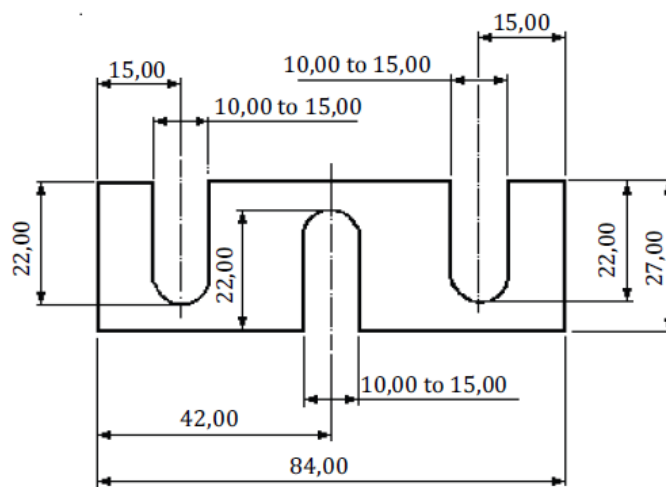
وسایل زیر مورد نیاز است:

الف - پروفیل‌سنج<sup>۱</sup> (به شکل ۳ رجوع شود).

ب- صفحه فلزی صلب که مطابق شکل ۴ بریده شده است. هر فلز صلب برای ساخت صفحه می‌تواند استفاده شود، اما برای رسیدن به وزن  $2,2 \text{ N} \pm 0,1 \text{ N}$  ضخامت آن باید با توجه به چگالی مواد تنظیم شود. تمام ابعاد صفحه باید با رواداری  $0,5 \text{ mm}$  یا بهتر باشد.



شکل ۳ - دستگاه اندازه‌گیری ارتفاع و پروفیل نوار مغناطیسی (بدون مقیاس)



شکل ۴ - صفحه نگه‌دارنده کارت - ناحیه اتصال (ابعاد برحسب میلیمتر، بدون مقیاس)

### ۲-۲-۵ روش انجام

کارت را برای آزمون در زیر صفحه فلزی صلب بریده‌شده مطابق شکل ۴، نگه دارید. ارتفاع و مقطع نوار مغناطیسی و اطراف سطح کارت را با استفاده از ابزار ضبط، اندازه‌گیری کنید.

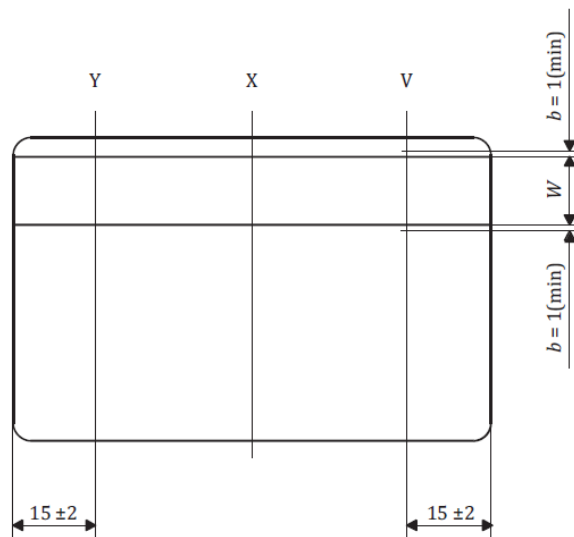


با استفاده از پراب با شعاع  $0.38 \text{ mm}$  تا  $2.54 \text{ mm}$ ، پروفیل را با حداکثر سرعت  $1 \text{ mm/s}$  و با اعمال نیروی  $0.5 \text{ mN}$  تا  $6 \text{ mN}$  اندازه بگیرید.

در سراسر عرض نوار برای هر نمونه سه اندازه‌گیری انجام دهید. موقعیت‌های V و Y فاصله  $15 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$  از هر انتهای کارت تعریف می‌شود و موقعیت X خط مرکزی کارت است (به شکل ۵ رجوع شود). در نواحی دیگر اگر ارتفاع یا انحراف سطح مقطع بیشتر از سه ناحیه تعیین شده باشد، باید در این نواحی نیز اندازه‌گیری انجام شود.

نقطه شروع برای اندازه‌گیری در امتداد هر یک از خطوط V، X، Y حداقل  $1 \text{ mm}$  از لبه بالای رسانه مغناطیسی شروع و حداقل  $1 \text{ mm}$  در زیر لبه پایین رسانه‌های مغناطیسی به پایان می‌رسد.

**یادآوری-** در آماده‌کردن کارت آزمون برای اندازه‌گیری مشخصات سطح، برای تعیین محل حداقل عرض نوار W در ثبت مشخصات، بهتر است با استفاده از یک چاقوی تیز به آرامی یک خط به موازات لبه مرجع بالای کارت ایجاد شود.



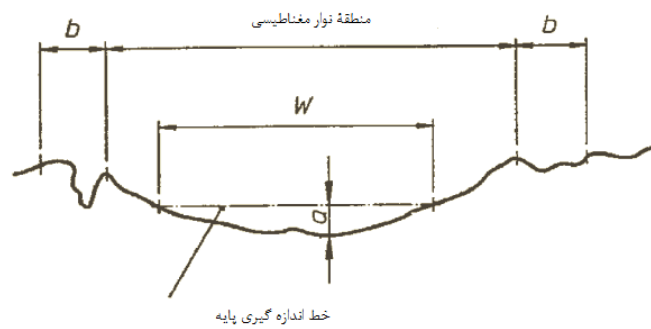
شکل ۵ - موقعیت اندازه‌گیری مشخصات نوار مغناطیسی (ابعاد به میلی‌متر، بدون مقیاس)

### ۵-۲-۳ بیان نتایج

#### ۵-۲-۳-۱ مشخصات سطح نوار مغناطیسی

برای اندازه‌گیری در امتداد خطوط V، X، Y (به شکل ۵ رجوع شود)، با اتصال نقاط بالا و پایین که لبه‌های حداقل عرض نوار را تعریف می‌کند، یک خط اندازه‌گیری پایه اولیه ایجاد کنید (به شکل‌های ۶ و ۷ رجوع شود). خط اندازه‌گیری پایه باید در  $10^\circ$  درجه از جهت ضبط جدول قرار داشته باشد.

حداکثر انحراف عمودی (الف) فاصله بین خط اندازه‌گیری پایه و دورترین نقطه رسانه مغناطیسی از خط اندازه‌گیری پایه است. اندازه‌گیری باید عمود بر جهت ضبط نمودار باشد.



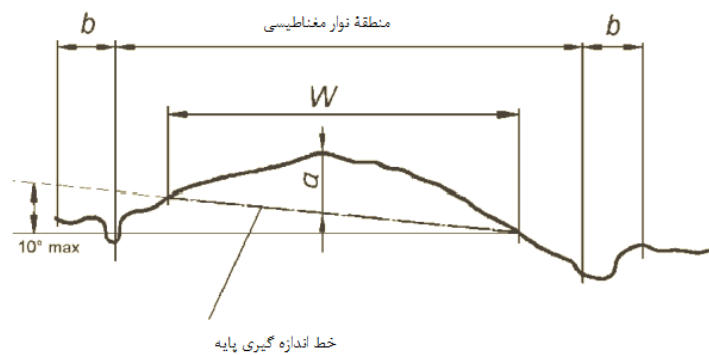
راهنما:

a حداکثر انحراف عمودی

b ۱ mm (حداقل)

W حداقل عرض نوار که در استاندارد پایه مربوط مشخص شده

شکل ۶ - پروفیل نوار مقعر



راهنما:

a حداکثر انحراف عمودی

b ۱ mm (حداقل)

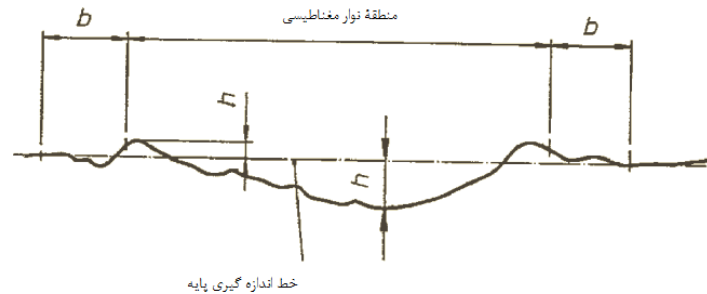
W حداقل عرض نوار که در استاندارد پایه مربوط مشخص شده

شکل ۷ - پروفیل نوار محدب

۵-۲-۳-۲ ارتفاع نوار مغناطیسی

سه اندازه‌گیری در امتداد خطوط V، X، Y با اتصال نقاط ابتدا و انتها، یک خط اندازه‌گیری اولیه را شکل می‌دهد (به شکل‌های ۸ و ۹ رجوع شود). خط اندازه‌گیری پایه باید در  $10^\circ$  از جهت ضبط نمودار قرار داشته باشد.

حداکثر انحراف عمودی ( $h$ ) فاصله بین خط اندازه‌گیری پایه و دورترین نقطه رسانه مغناطیسی از خط اندازه‌گیری پایه است. اندازه‌گیری باید عمود بر جهت ضبط نمودار باشد.

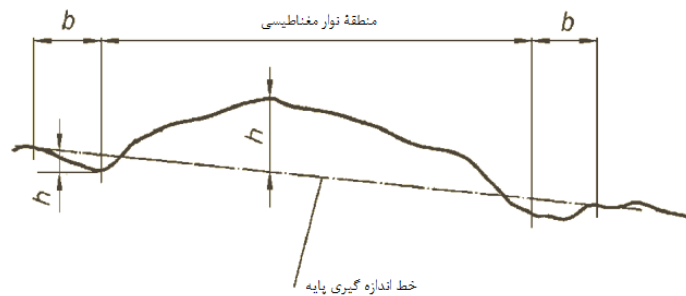


راهنما:

$b$  ۱ mm (حداقل)

$h$  حداکثر انحراف عمودی مشخص شده در استاندارد پایه مربوط

شکل ۸ - پروفیل نوار مقعر



راهنما:

$b$  ۱ mm (حداقل)

$h$  حداکثر انحراف عمودی مشخص شده در استاندارد پایه مربوط

شکل ۹ - پروفیل نوار محدب

۵-۲-۴ گزارش آزمون

۵-۲-۴-۱ پروفیل سطح نوار مغناطیسی

گزارش آزمون باید مقادیر سه اندازه‌گیری حداکثر انحراف عمودی ( $a$ ) را که در امتداد خطوط V، X و Y به دست آمده است، ارائه دهد.

۵-۲-۴-۲ ارتفاع نوار مغناطیسی

گزارش آزمون باید مقادیر سه اندازه‌گیری حداکثر انحراف عمودی ( $h$ ) را که در امتداد خطوط  $V$ ،  $X$  و  $Y$  به دست آمده است، ارائه دهد.

### ۳-۵ زبری سطح نوار مغناطیسی

هدف از انجام این آزمون، تعیین درجه زبری نوار مغناطیسی کارت آزمون است (به استاندارد ایران ایزو آی‌ای سی ۷۸۱۱-۲، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO/IEC7811-6، ISO/IEC7811-7، ISO/IEC8484 رجوع شود).

### ۱-۳-۵ روش انجام

زبری سطح نوار مغناطیسی باید با استفاده از ابزار ضبط اندازه‌گیری مطابق شکل ۳ اندازه‌گیری شود. حداقل سه اندازه‌گیری در هر جهت انجام دهید، به گونه‌ای که این اندازه‌گیری‌ها متعلق به مناطقی باشند که در آن زبری سطح در بدترین شرایط به نظر می‌رسد.

همه شرایط آزمون مشخص شده در زیربند ۵-۲ اعمال می‌شود به استثنای موارد زیر:

- سوزن پراب دارای شعاع  $2\ \mu\text{m}$  یا  $5\ \mu\text{m}$  است؛

- طول موج قطع و طول ارزیابی زبری باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۸ و استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۲۸ انتخاب شود.

- اندازه‌گیری‌های طولی و عرضی در نوار انجام گرفته است.

### ۲-۳-۵ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید مقادیر متوسط خط مرکزی  $R_a$  مربوط به زبری نوار مغناطیسی است که از اندازه‌گیری در هر دو جهت طولی و عرضی به دست آمده است.

### ۴-۵ آزمون سایش برای نوار مغناطیسی

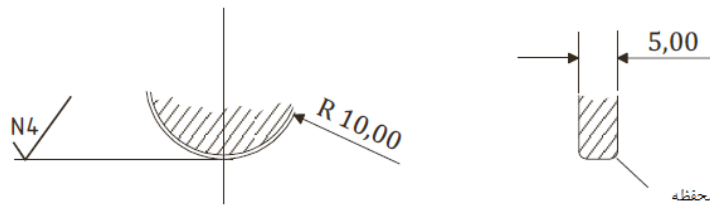
هدف از انجام این آزمون تعیین دامنه سیگنال نوار مغناطیسی یک نمونه آزمون کارت پس از سایش کنترل شده است (به استاندارد ایران ایزو آی‌ای سی ۷۸۱۱-۲، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO/IEC7811-6، ISO/IEC7811-7 رجوع شود).

### ۱-۴-۵ وسایل

سر ساختگی فلزی<sup>۱</sup> که سختی آن بین HV ۱۳۰ - HV ۱۱۰ (مقیاس ویکرز) یا معادل آن در مقیاس راکول است. ابعاد مورد نیاز در شکل ۱۰ نشان داده شده است و صفحه مسطح صلب قادر به نگه‌داشتن کارت.

---

1 - Metal dummy head



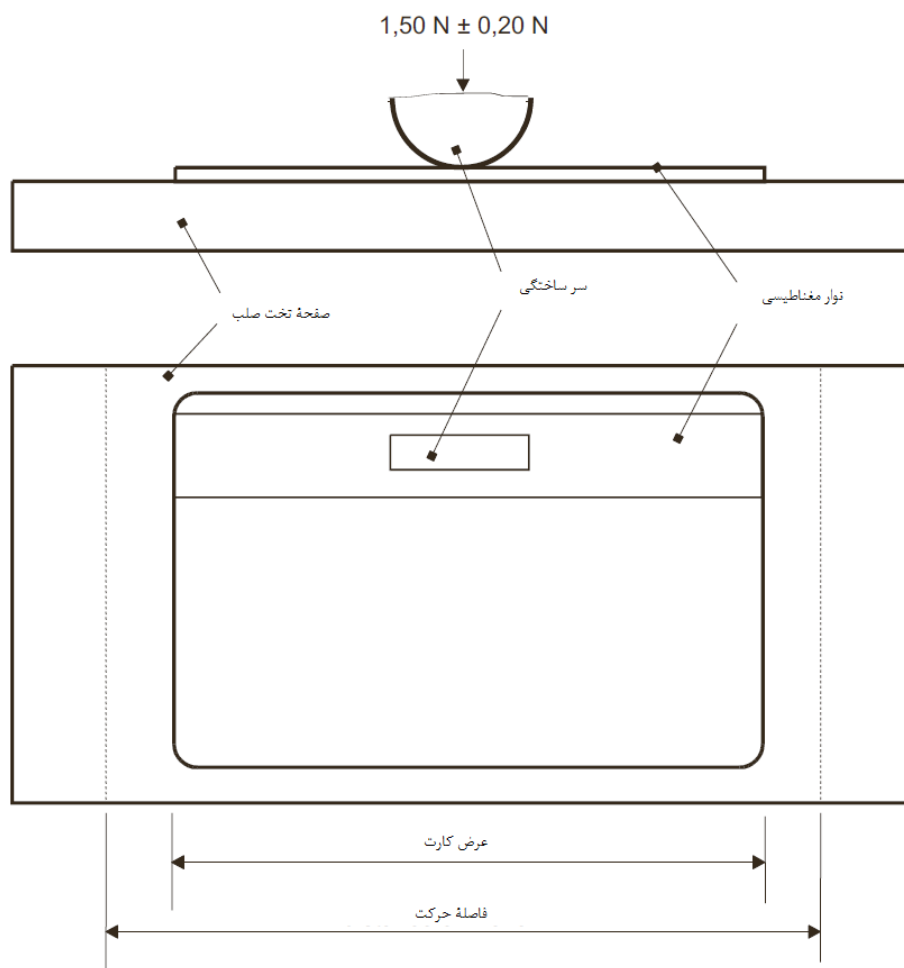
شکل ۱۰ - ابعاد سطح تماس سر ساختگی (ابعاد برحسب میلیمتر، بدون مقیاس)

#### ۵-۴-۲ روش انجام

کارت نمونه را در  $20 \text{ ft/mm}$  با استفاده از یک جریان ضبط آزمون  $I_{\min}$  ضبط کنید، دامنه سیگنال را بخوانید و یادداشت کنید، به صورتی که در استاندارد پایه مشخص شده است، اندازه‌گیری کنید.

کارت را از رویه نوار مغناطیسی به صفحه تخت محکم کنید، به طوری که سر ساختگی بتواند از طول نوار عبور کند و یا به طور جایگزین، کارت بتواند در زیر سر حرکت کند (به شکل ۱۱ رجوع شود). در هنگام نصب کارت بر روی صفحه صلب مطمئن شوید در طی زمان انجام آزمون کارت صاف و ثابت نگه‌داشته شود.

نیروی  $0,2 \text{ N} \pm 1,5 \text{ N}$  به سر اعمال کنید و برای  $2000$  چرخه اجازه دهید که سر با سرعتی بین  $200 \text{ mm/s}$  تا  $500 \text{ mm/s}$  به عقب و جلو حرکت کند (هر چرخه معادل یک حرکت به جلو و یک حرکت به عقب است). دامنه سیگنال را با همان دستگاه بخوانید و نتیجه را با دامنه به دست آمده در آغاز آزمون مقایسه کنید. موقعیت سرهای خواندن و نوشتن باید به طور کامل در داخل منطقه تحت سایش سر ساختگی باشد.



شکل ۱۱ - سر ساختگی و نوار مغناطیسی (بدون مقیاس)

### ۵-۴-۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید مقادیر دامنه سیگنال تعریف شده در استاندارد پایه را قبل و بعد از سایش ارائه دهد.

### ۵-۵ اندازه‌گیری‌های دامنه

هدف از انجام این آزمون اندازه‌گیری دامنه سیگنال، تفکیک‌پذیری، خراشیدگی، مغناطیس‌زدایی و ویژگی‌های شکل موج نوار مغناطیسی یک نمونه کارت آزمون، به منظور بررسی انطباق با استاندارد پایه مناسب به صورت زیر است.

واپارندگی تقریبی	تراکم ضبط	استاندارد قابل کاربرد
$\leq 35 \text{ kA/m (440 Oe)}$	$\leq 12 \text{ bpmm (300 bpi)}$	INSO-ISO-IEC 7811-2, ISO/IEC 8484
$\geq 80 \text{ kA/m (1000 Oe)}$	$\leq 12 \text{ bpmm (300 bpi)}$	ISO/IEC 7811-6
$\geq 80 \text{ kA/m (1000 Oe)}$	40 bpmm (1016 bpi)	ISO/IEC 7811-7
51,7 kA/m (650 Oe)	$\leq 12 \text{ bpmm (300 bpi)}$	ISO/IEC 7811-8

یادآوری - مغناطیس‌زدایی و ویژگی‌های شکل موج برای تمام استانداردها کاربرد ندارد.

## ۵-۵-۱ مرجع کالیبراسیون

کارت‌های مرجع کالیبراسیون باید با توجه به استاندارد پایه‌ای که با آن انطباق دارند، برای بررسی انتخاب شوند:

کارت مرجع	استاندارد پایه
RM 7811-2	INSO-ISO-IEC 7811-2, ISO/IEC 7811-8, ISO/IEC 8484
RM 7811-6	ISO/IEC 7811-6
RM 7811-7	ISO/IEC 7811-7

**یادآوری -** مواد تمیزکاری ممکن است باعث تخریب خواص معتبر شود. هر کارت مرجع به این صورت، دیگر نمی‌تواند معتبر تلقی شود و باید از بین برده شود.

## ۵-۵-۲ دستگاه

سیستم ضبط / بازخوانی مطابق با مشخصات ارائه‌شده در زیربندهای ۵-۲-۱ تا ۵-۲-۴، مورد نیاز است.

## ۵-۲-۱ درایو مکانیکی

کارت باید در طول اندازه‌گیری تخت نگه داشته شود.

سیستم درایو باید دارای سرعت متوسط انتقال با بازه تغییر کمتر از  $\pm 0.5\%$  و فشار پایدار در سر باشد. اگر درایو استفاده‌شده دارای تغییرات سرعت بیشتر از  $\pm 0.5\%$  باشد، تغییر سرعت واقعی باید به همراه نتایج آزمون ثبت شود.

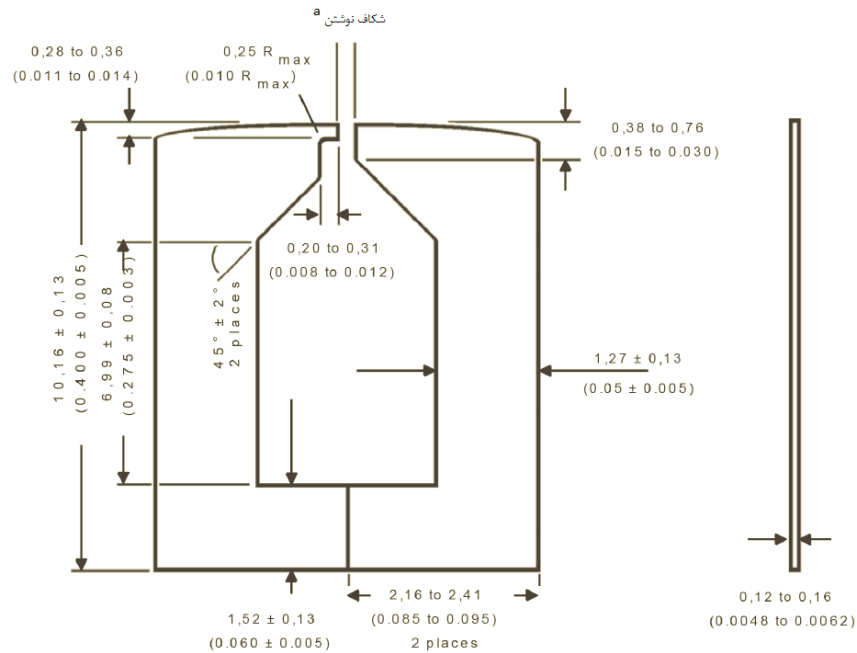
**یادآوری -** تغییرات در سرعت و فشار سر، درستی اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد. به طور خاص، باید توجه داشت که تغییرات سرعت ناگهانی (گذرا) درستی اندازه‌گیری‌های دامنه سیگنال اختصاصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

## ۵-۲-۲ درایو سرهای آزمون

سرهای آزمون باید شامل سرهای مجزای نوشتن و خواندن با بدنه ساخته‌شده از مواد غیر مغناطیسی، مانند برنج یا آلومینیوم باشد.

برای اطمینان از پاسخ فرکانسی مناسب، سر خواندن باید از فلز ورقه‌ای با حداکثر ضخامت  $0.18\text{ mm}$  ساخته شده باشد.

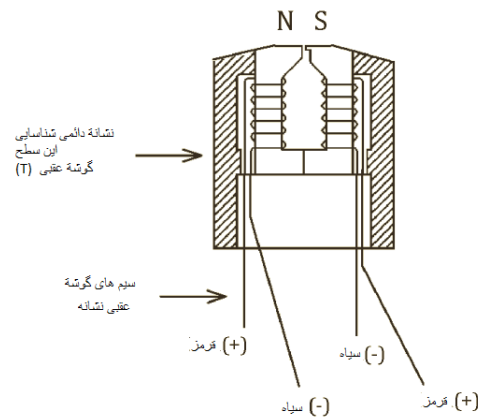
هسته سر نوشتن باید از لایه‌های فلزی مطابق با شکل ۱۲ ساخته شود. مواد شکاف جلویی باید مس بریلیوم، بدون ناخالصی فرومغناطیسی باشد. پوشش مقاوم در برابر سایش نباید استفاده شود (به پیوست الف رجوع شود).



<sup>a</sup> برای مقادیر به جدول ۲ رجوع شود.

شکل ۱۲- لایه‌های سر نوشتن آزمون (ابعاد برحسب میلیمتر، بدون مقیاس)

سیم پیچ ۱۰۰ دوری باید در هر ساق از هسته سر نوشتن، با تمام چهار هادی منتهی به هادی‌های خارجی، مطابق با شکل ۱۳ در کمتر از دو لایه پیچیده شود.



شکل ۱۳- اتصالات سیم پیچ سر نوشتن آزمون (بدون مقیاس)

عرض شکاف و شیار و غیره در جدول ۲ داده شده است. همه مقادیر در جدول باید به صورت نوری اندازه‌گیری شود.



جدول ۲ - مشخصات سرهای آزمون

کارکرد سر	خواندن		نوشتن		
استاندارد پایه	ISO/IEC 7811-2 ISO/IEC 7811-6 ISO/IEC 7811-8 ISO/IEC 8484	ISO/IEC 7811-7	ISO/IEC 7811-2 ISO/IEC 7811-8 ISO/IEC 8484	ISO/IEC 7811-6	ISO/IEC 7811-7
ضخامت لایه	حداکثر ۰٫۱۸ mm		به شکل ۱۲ رجوع شود.		
شعاع انحناء†	٪ ± ۱۰ ۱۹ mm برای یک سر جدید. یک ناحیه صاف در شکاف بلامانع است.				
عرض تماس با نوار	۲٫۸ mm تا ۳٫۵ mm				
عرض هسته مغناطیسی	۱٫۴ mm ± ۱۰ ٪ (۰٫۰۵۵ in ± ۱۰ ٪)	۰٫۵ mm ± ۱۰ ٪ (۰٫۲ in ± ۱۰ ٪)	حداقل ۲٫۷۹ mm (۰٫۱۱ in)		حداقل ۱ mm (۰٫۰۴ in)
شکاف	۱۲٫۷ μm ± ۱۰ ٪	۶ μm ± ۱۰ ٪	۰٫۲۵ mm ± ۱۰ ٪	۰٫۵۱ mm ± ۱۰ ٪	۰٫۲۵ mm ± ۱۰ ٪
القای اشباع			حداقل ۰٫۸ T (۸ کیلو گوس)	حداقل ۲٫۳ T (۲۳ کیلو گوس)	
† اندازه ناحیه مسطح سر آزمون روی توانایی ارتباط مناسب با نوار مغناطیسی تاثیر می‌گذارد. با سایش سر آزمون، کالیبراسیون مجدد لازم است.					

سرها به گونه نصب شده‌اند که به صورت مکانیکی مستقل از یکدیگر هستند و خطای پیمایش کمتر از ۱۰ دقیقه است. آنها باید طوری تراز باشند که خط مرکزی شیار خواندن در  $\pm 0.15 \text{ mm}$  خط مرکزی شیار نوشته شده قرار داشته باشد.

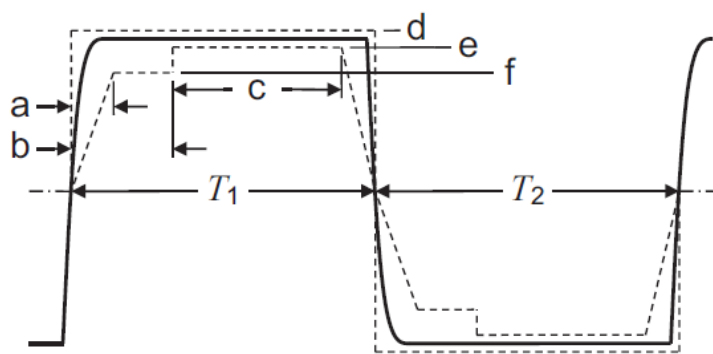
نیروی سرها باید در حداقل مقدار مورد نیاز جهت رسیدن به حداکثر خروجی کارت مرجع در زمان تنظیم قرار گیرد. اما نباید بیش از ۷ N باشد.

یادآوری - نیروی یک سر معمولاً ۳ N است.

#### ۵-۲-۳ درایو سر نوشتن

شکل موج جریان ضبط I، در تراکم‌های ضبط اسمی ۸ ft/mm و ۲۰ ft/mm باید مطابق با شکل ۱۴ باشد. شکل موج جریان باید در حدود نشان داده شده به صورت خطوط شکسته باقی بماند.

مورد نیاز برای استاندارد ISO/IEC 7811-7	مورد نیاز برای استانداردهای ISO/IEC 7811-2 7811,7811-8,8484	متغیر در شکل ۱۴
$0,10 (T1 + T2)$	$0,05 (T1 + T2)$	a
$0,35 (T1 + T2)$	$0,15 (T1 + T2)$	b
$0,10 (T1 + T2)$	$0,30 (T1 + T2)$	c
$1,02 I$	$1,02 I$	d
$0,98 I$	$0,98 I$	e
$0,9 I$	$0,90 I$	f
$T1 = T2 \pm 0.02 T1$	$T1 = T2 \pm 0.05 T1$	قرینه



شکل ۱۴ - شکل موج جریان ضبط

#### ۵-۲-۴ خواندن زیرسیستم<sup>۱</sup>

پسماند موثر سر خواندن زمانی که به زیرسیستم بازخوانی متصل است، نباید دامنه سیگنال متوسط کارت مرجع استفاده شده بیش از ۵٪ بعد از ۵ مرحله فقط خواندنی پی‌درپی را کاهش دهد.

وضوح زیرسیستم بازخوانی در هنگام آزمون بر روی کارت مرجع با استفاده از یک جریان ضبط آزمایشی  $I_{max}$  (به زیربند ۵-۳-۳ رجوع شود) و تراکم ضبط آزمایشی زیر، باید بین ۸۵٪ و ۱۰۰٪ باشد:

تراکم ضبط آزمایش	استاندارد پایه ISO/IEC
8 ft/mm (200 ft/in) and 20 ft/mm	7811-2, 7811-6, 7811-8, 8484
20 ft/mm (508 ft/in) and 40 ft/mm	7811-7

که باید شامل موارد زیر باشد:

الف- یک تقویت‌کننده خطی

تقویت‌کننده باید بدون کنترل اتوماتیک بهره و با نوفه کمتر از  $0,5 U_R$  (به زیربند ۵-۳-۲ رجوع شود) و دارای پاسخ فرکانسی مسطح در حدود  $\pm 0,2 \text{ dB}$  بین فرکانس متناظر با موقعیت‌های ۲ و ۳ شکل ۱۵ باشد.

این گستره متناظر با ویژگی‌های باند گذر فیلتر شرح داده شده در بند پ است. خارج از این گستره، ممکن است پاسخ افزایش نیابد.

ب- وسایل نمایش و اندازه‌گیری

تجهیزاتی مانند اسیلوسکوپ قوی برای تعیین دامنه پیک‌های سیگنال.

پ- فیلتر باند گذر

این فیلتر باید برای تمام اندازه‌گیری‌ها به جز پاک‌شدگی ( $U_{A4}$ ) و پالس اضافی ( $U_{i4}$ ) استفاده شود.

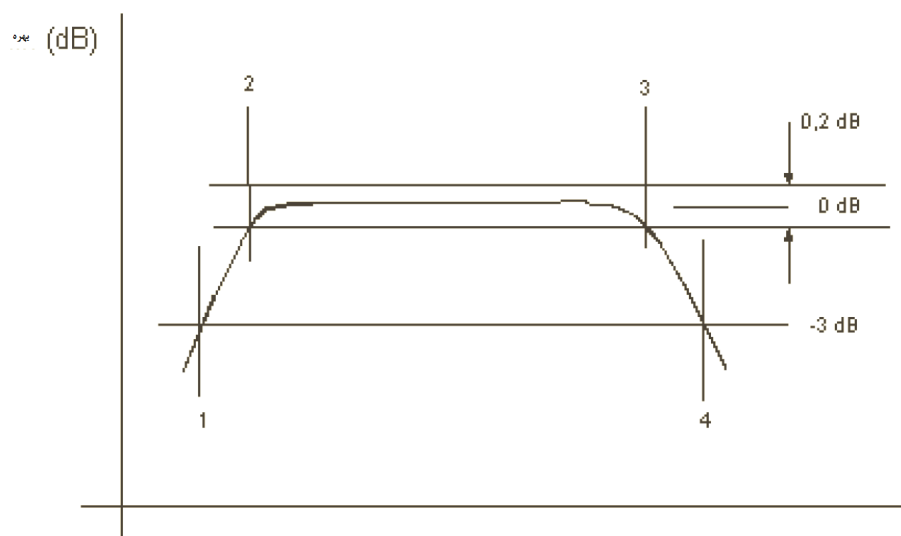
لبه‌های باند بالا و پایین فیلتر باید پاسخ درجه دوم (شیب ۱۲ dB/octave) نشان دهند.

پاسخ باند گذر فرکانس‌های مربوط به ۰٫۲۵ cycle/mm تا ۱۰٫۵ cycle/mm باید به صورت صاف با اعوجاجی در

حدود ۰٫۲ dB باشد. شکل ۱۵ ویژگی‌های مورد نیاز را نشان می‌دهد.

پاسخ فیلتر باید برای حداقل یک دهه پس از لبه‌های باند رو به پایین ادامه یابد و نباید بیش از ۴۰ dB - خارج از

محدوده این دهه افزایش یابد. توابع دیگر فیلترکردن در خارج از محدوده‌های یک دهه ممکن است استفاده شود.



تراکم ضبط آزمون یا تراکم انتقال شار

تراکم انتقال شار آزمون		تراکم ضبط آزمون		موقعیت
ISO/IEC 7811-۷	ISO/IEC 7811-2 ISO/IEC 7811-6 ISO/IEC 7811-8 ISO/IEC 8484	ISO/IEC 7811-7	ISO/IEC 7811-2 ISO/IEC 7811-6 ISO/IEC 7811-8 ISO/IEC 8484	استاندارد پایه
Ft/mm(ft/in)		cycles/mm(cycles/in)		
0.018 (0.46)		0.009 (0.23)		۱
0.05 (1.27)		0.025 (0.63)		۲
56 (1422)	21 (533)	28 (711)	10.5 (267)	۳
160 (4064)	60 (1524)	80 (2032)	30 (762)	۴

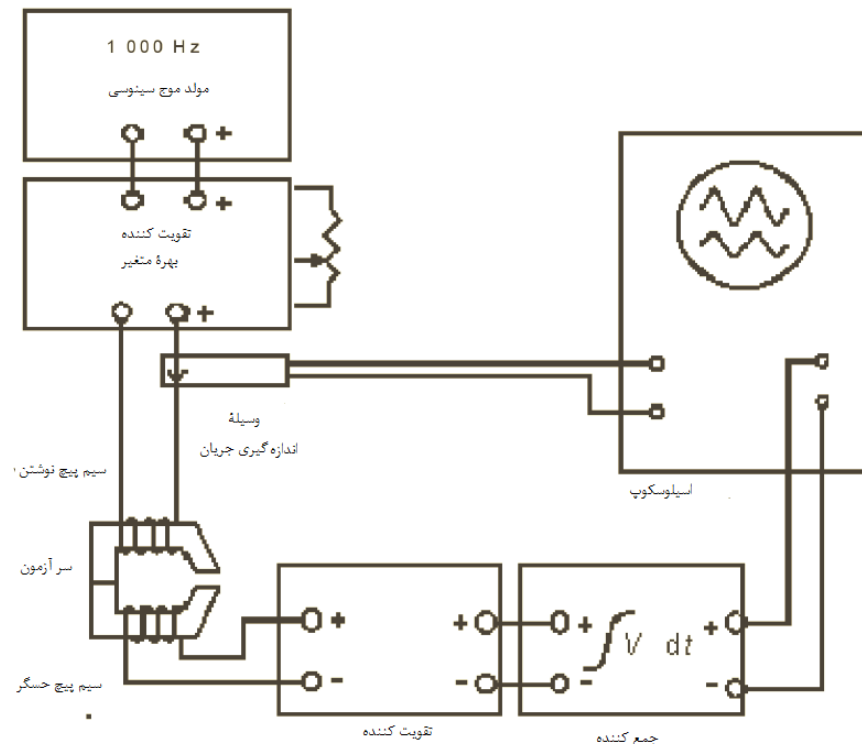
شکل ۱۵ - مشخصه فیلتر

### ۳-۵-۵ روش انجام

ترتیب کل اندازه‌گیری‌ها باید بر روی تجهیزات یکسان و تحت شرایط یکسان انجام گیرد. تمام اندازه‌گیری‌ها باید به هنگام خواندن در جهت ضبط و پس از تعداد مراحل یکسان انجام شود.

### ۱-۳-۵-۵ تعیین مشخصه شار/جریان سر نوشتن آزمون

سر نوشتن را برای یافتن ارتباط بین شار خروجی و جریان نوشتن به روش زیر مشخص کنید. برای هر دامنه جریان ( $I$ )، دامنه شار متناظر ( $F$ ) را با استفاده از دستگاه مطابق شکل ۱۶ یادداشت کنید. خطی بودن ولتاژ/جریان منبع جریان باید بهتر از  $\pm 2\%$  باشد. اتلاف جمع‌کننده  $= 2000\pi \times RC$  تقریباً  $6283 \times RC$  باید حداقل ۲۰۰ باشد.



شکل ۱۶ - راه اندازی آزمون مشخصه‌های سر نمونه

### ۲-۳-۵-۵ تعیین $I_R$ و $U_{max}$ کارت مرجع

منحنی اشباع را برای تعیین دامنه سیگنال حداکثر ( $U_{max}$ ) و جریان مرجع ( $I_R$ ) با استفاده از کارت مرجع (به زیربند ۱-۵-۵ رجوع شود) و تراکم ضبط آزمون کالیبراسیون مناسب با استاندارد پایه، رسم کنید. برای هر دامنه جریان، مقادیر مربوط به دامنه سیگنال متوسط کارت مرجع را یادداشت کنید.

استاندارد پایه ISO/ IEC	تراکم های ضبط آزمون
7811-2, 7811-6, 7811-8, 8484	8 ft/mm
7811-7	20 ft/mm

قبل از ضبط در هر دامنه جریان، کارت را با جریان متناوب فرکانس بالا پاک کنید. درجه پاک شدن باید به قدری باشد که اطمینان حاصل شود سیگنال باقی مانده متوسط کمتر از  $U_R$  ۰٫۵ است.

این فرآیند کالیبراسیون (که مقادیر  $U_R$  و  $I_R$  کارت مرجع را تعیین می کند) باید طوری انجام شود که مرحله ضبط در کارت مرجع به طور مستقیم با مرحله خواندن دنبال شود.

فرآیند کالیبراسیون را حداقل سه بار تکرار کنید. اگر تغییر خروجی بزرگتر از ۲٪ (مثلاً ۱٪ ±) باشد، فرآیند کالیبراسیون را تکرار کنید.

**یادآوری ۱-** هر گونه تماس با سرهای خواندن یا نوشتن که پس از مرحله ضبط، قبل از خواندن اتفاق می افتد، ممکن است بر مقدار حاصل از  $U_R$  تاثیر بگذارد.

**یادآوری ۲-** به کاربر توصیه می شود، درستی کارت مرجع را به صورت دوره ای با مقایسه خروجی سیگنال در میان پنج کارت مرجع بررسی کند.

### ۵-۳-۳ کسب مقادیر مرجع

دامنه سیگنال مرجع  $U_R$  را محاسبه کنید و جریان های ضبط ( $I_{min}$  و  $I_{max}$ ) را برای کارت مرجع ثانویه به شرح زیر آزمون کنید. فاکتورهای تصحیح توسط ارائه دهنده کارت های مرجع ثانویه تامین می شود.

الف -  $U_R$  = (دامنه حداکثر مرجع ثانویه) \* (فاکتور تصحیح دامنه)

فاکتور تصحیح دامنه = (دامنه مرجع ثانویه) / (دامنه استاندارد اولیه)

ب -  $I_R$  = (جریان مرجع ثانویه) \* (فاکتور تصحیح جریان)

جریان مرجع ثانویه = جریان هنگامی که  $U$ ، ۸۰٪ حداکثر مرجع ثانویه است.

فاکتور تصحیح جریان = (جریان مرجع ثانویه) / (جریان استاندارد اولیه)

پ -  $F_R$  = شار مرجع زمانی که جریان  $I_R$  است.

ت -  $I_{min}$  و  $I_{max}$  مقادیر جریان وابسته به استاندارد پایه:

شار جریان سطح $I_{max}$	سطح شار جریان $I_{min}$	استاندارد پایه ISO/IEC
$5.0 \times FR$	$3.5 \times FR$	7811-2, 8484
$3.5 \times FR$	$2.8 \times FR$	7811-6
$2.5 \times FR$	$2.2 \times FR$	7811-7
$8.0 \times FR$	$6.5 \times FR$	7811-8

### ۵-۳-۴ اندازه‌گیری کارت تحت آزمون

کارت تحت آزمون را تحت شرایط آزمون‌های مختلف تعریف‌شده توسط استاندارد پایه ضبط کنید و بخوانید. کارت تحت آزمون را با جریان متناوب فرکانس بالا قبل از آزمون و قبل از هر آزمون اختصاصی به جز برای پاک شدن و پالس اضافی، پاک کنید. درجه پاک شدن باید به اندازه‌ای کافی باشد که به طور متوسط سیگنال باقی مانده کمتر از  $0.05 U_R$  باشد.

کارت را بین هیچ دو ضبط آزمون بازنویسی پاک نکنید. به طور خاص آزمایشی که نیازمند مقایسه ای بین دامنه سیگنال‌های قبل و بعد از بازنویسی هستند.

قبل از پاک کردن کارتی که تحت آزمون پاک‌شدن و اندازه‌گیری پالس اضافی قرار دارد، آن را با مقدار  $I_{max}$  مناسب با استاندارد پایه و تراکم آزمون زیر ضبط کنید:

تراکم‌های ضبط آزمون	استاندارد پایه ISO/IEC
8 ft/mm	7811-2, 7811-6, 7811-8, 8484
20 ft/mm	7811-7

قبل از انجام آزمون برای مغناطیس‌زدایی مطابق با الزامات استاندارد پایه، آن را با مقدار  $I_{min}$  مناسب با استاندارد پایه و تراکم آزمون زیر ضبط کنید:

تراکم ضبط آزمون	استاندارد پایه ISO/IEC
20 ft/mm	7811-6
40 ft/mm	7811-7

### ۵-۵-۴ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید مقادیر اندازه‌گیری‌شده برای کمیت‌های تعریف‌شده طبق استاندارد پایه را بدهد. علاوه بر عدم قطعیت کلی اندازه‌گیری مرتبط با هر کمیت، تغییر سرعت اندازه‌گیری‌شده درایو در صورتی که بیش از  $\pm 0.5\%$  باشد باید ذکر شود و اینکه آیا سرهای آزمون شامل پوشش مقاوم در برابر سایش است.

### ۵-۶ تغییر فاصله گذار شار

هدف از این آزمون تعیین تغییر در مواضع انتقال شار در یک نمونه کارت آزمون کدگذاری‌شده است. (به استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۲-۷۸۱۱، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO/IEC7811-6، ISO/IEC7811-7، ISO/IEC8484 رجوع شود).

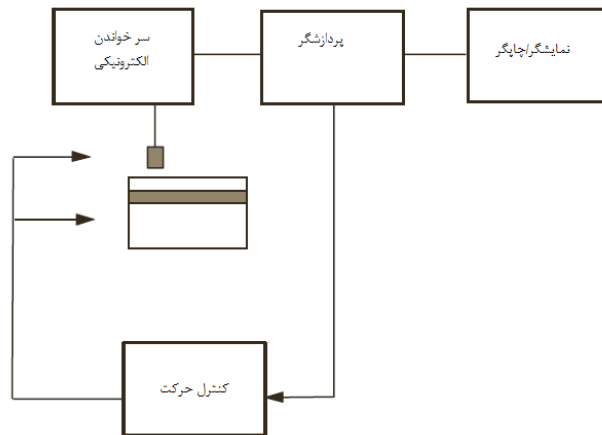
### ۵-۶-۱ دستگاه

دستگاه برای اندازه‌گیری انتقال تغییر فاصله گذار باید مطابق با زیربندهای ۵-۲-۱ و ۵-۲-۴ باشد. همچنین باید با قسمت‌های مربوط به سر خواندن زیربند ۵-۲-۲ مطابقت داشته باشد.

به طور خاص، دستگاه باید یک درستی موضعی  $\pm 0,5\%$  در  $40 \text{ ft/mm}$  برای تمام سرعت‌های عملکرد به هنگام آزمون را حفظ کند و باید چنان ساخته شده باشد که از نخاله‌ها و آلودگی‌ها محافظت شود. سر خواندن باید به گونه‌ای تراز قرار گیرد که خط مرکزی شیار خواندن در  $\pm 0,15 \text{ mm}$  خط مرکزی از شیار نوشته‌شده تحت آزمون بیفتد.

**یادآوری** - موقعیت سر یا موقعیت کارت ممکن است در حالی که دیگری ثابت نگه داشته شده است، اندازه‌گیری شود.

شکل ۱۷ شمای بلوکی از دستگاه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۷ - مثالی از شمای اندازه‌گیری

### ۵-۶-۲ روش انجام

آزمونه کارت را در دستگاه قرار دهید.

نیروی وارد بر روی سر باید حداقل مقدار مورد نیاز برای رسیدن به حداکثر خروجی کارت تحت آزمون در زمان اندازه‌گیری باشد اما نباید از  $7 \text{ N}$  فراتر رود.

دستگاه را فعال کرده و فاصله بین پیک‌های سیگنال مجاور را به دست آورید.

### ۵-۶-۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید مقادیر اندازه‌گیری شده کمیتهای تعریف شده توسط استاندارد پایه را به همراه مقادیر عدم قطعیت کلی اندازه‌گیری هر یک ارائه دهد.

### ۵-۷ چسبندگی نوار مغناطیسی

هدف از انجام این آزمون تعیین میزان چسبندگی بین نوار مغناطیسی و بدنه یک نمونه کارت آزمون است (به استاندارد ایران ایزو آی ای سی ۷۸۱۱-۲، استاندارد ملی ایران شماره ۸-۸۴۵۶ و استانداردهای ISO/IEC7811-6، ISO/IEC7811-7، ISO/IEC8484 رجوع شود).

### ۵-۷-۱ وسایل

وسایل زیر مورد نیاز است:

- ابزار برش تک تیغه به صورتی که در استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۰۵: سال ۱۳۹۲ تعریف شده است.
- نوار چسب شفاف با استحکام چسبندگی مشخص شده در زیربند ۳-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۵۹۰۵: سال ۱۳۹۲ و آزمون شده مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۸۸۰ و عرض کمتر از ۲۰ mm.
- نگه‌دارنده کارت شامل صفحه فلزی مستطیلی صلب با شکاف مستطیل شکل به ابعاد ۲۵ mm × ۵۰ mm.

### ۵-۷-۲ روش انجام

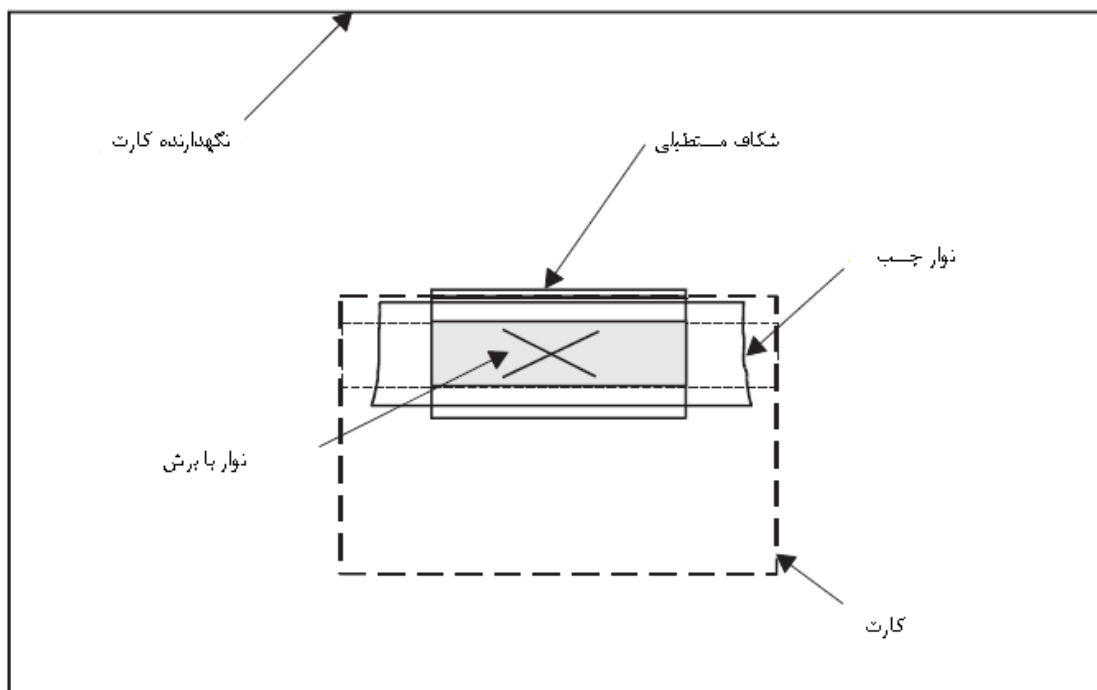
در نوار دو برش به طول حدود ۲۰ mm ایجاد کنید، به طوری که در نزدیکی وسط نوار همدیگر را با زاویه حدود ۲۰° تا ۴۵° قطع می‌کنند. هنگام ایجاد برش‌ها، از کنار نگه‌دارنده کارت استفاده کنید و برش را روی نوار با یک حرکت مداوم ایجاد کنید.

نگه‌دارنده کارت را بر روی کارت با شکاف متمرکز شده بر روی تقاطع برش‌ها قرار دهید. یک طول ۷۵ mm از نوار حساس به فشار را ببرید و نوار را بر روی شیار شکاف نگه‌دارنده کارت قرار دهید. با استفاده از نوک انگشت نوار را به روی محل در ناحیه برش صاف کنید.

شکل ۱۸ کارت قرار گرفته در زیر نگه‌دارنده را با نوار چسب در جای خود نشان می‌دهد. در مدت ۵ min پس از استفاده از نوار، آن را با گرفتن سر آزاد و کشیدن آن به طور پیوسته بردارید، به طوری که این عمل در مدت ۰٫۵ s تا ۱ s در حالی که زاویه ۶۰° بین بخش جدا از نوار و باقی‌مانده روی سطح کارت انجام گیرد. نگه‌دارنده کارت برای جلوگیری از هرگونه حرکت کارت در طول لایه‌برداری باید به صورت محکم نگه داشته شود.

نوار و سطح مقطع برش نوار را بررسی کنید. هرگونه شواهدی از حذف مواد مغناطیسی کارت را ثبت کنید.





شکل ۱۸ - آزمون چسبندگی نوار مغناطیسی (به مقیاس نیست)

### ۵-۷-۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید بیان کند که آیا، در بازرسی نهایی، ماده‌ای از کارت حذف شده است. اگر هر گونه حذفی پیدا شد گزارش آزمون باید ماهیت و شدت آن را توضیح دهید.

### ۵-۸ مشخصه‌های مغناطیسی استاتیک

هدف از انجام این آزمون تعیین مشخصه‌های مغناطیسی استاتیکی نوار مغناطیسی است که در پیوست استانداردهای ISO/IEC 7811-6 و ISO/IEC 7811-7 مشخص شده است. برای تعریف مقادیر مورد استفاده در این روش آزمون، به تعیین ویژگی‌های مغناطیسی استاتیکی در پیوست استانداردهای ISO/IEC 7811-6 و ISO/IEC 7811-7 رجوع شود.

**یادآوری -** مشخصه‌های مغناطیسی استاتیکی برای استانداردهای ISO/IEC 7811-6 و ISO/IEC 7811-7 در پیوست‌های اطلاعاتی تعریف شده است و حاوی اطلاعاتی برای راهنمایی است. این روش آزمون تنها برای اطمینان از سازگاری نتایج به هنگامی که الزامات مورد نیاز مشخصات مغناطیسی استاتیکی اعمال شده، ارائه شده است.

### ۵-۸-۱ وسایل

تجهیزات دارای قابلیت‌های زیر است:

الف- حداکثر میدان آزمون:  $\pm H_{max} = \pm 1200 \text{ kA/m}$  ( $\pm 15,000 \text{ Oe}$ )

ب- قابلیت درستی اندازه‌گیری:  $H_c \pm 2\%$ ,  $SQ_{||} \pm 2\%$ ,  $SFD$  (or  $SFS$ )  $\pm 4\%$ ,  $SQ_{\perp} \pm 6\%$ ,  $S160 \pm 4\%$

### ۵-۸-۲ روش انجام

#### ۵-۸-۲-۱ شرایط آزمون

دمای نمونه  $21^{\circ}\text{C}$  تا  $23^{\circ}\text{C}$  (به طور پیش‌فرض، دمای اتاق).

یادآوری- دمای نمونه در طی آزمون مقدار اندازه‌گیری شده  $H_{CM}$  را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

#### ۵-۸-۲-۲ آماده‌سازی

مطابق با دستورالعمل سازنده تجهیزات را کالیبره کنید.

مطابق با دستورالعمل سازنده نمونه را آماده کنید.

#### ۵-۸-۲-۳ اندازه‌گیری‌ها

مقادیر مورد نیاز را، مطابق با توضیحات زیر، اندازه‌گیری کنید.

#### ۵-۸-۲-۴ اندازه‌گیری حلقه پسماند در جهت طولی

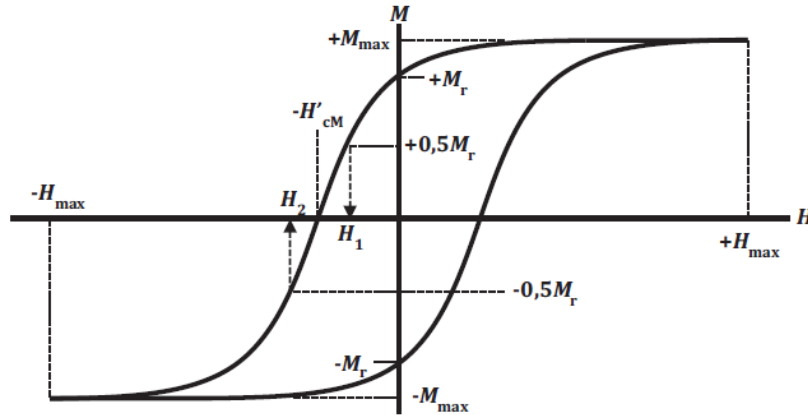
جهت نمونه را طوری قرار دهید که جهت طولی به موازات جهت میدان باشد.

ممان مغناطیسی  $M$ ، نمونه را در گستره  $\pm H_{max}$  اندازه‌گیری کنید.

حلقه پسماند را با استفاده از داده گرفته شده در هر  $40 \text{ kA/m}$  ( $500 \text{ Oe}$ ) حداکثر تا لحظه که گشتاور مغناطیسی

( $M$ ) دیگر تغییر نکند و هر  $4$  کیلو آمپر / متر ( $50 \text{ Oe}$ ) حداکثر در منطقه  $H'_{CM}$ ، رسم کنید. مثال در شکل ۱۹

نشان داده شده است.



شکل ۱۹ - مثالی از یک حلقه پسماند

از حلقه پسماند به دست آمده، مقادیر کمیت‌های زیر را به دست آورید:

- وادارندگی  $H'_cM$  نمونه؛

- اشباع مغناطیسی در  $H_{max}$  و  $M_{max}$ .

- پسماند مغناطیسی  $M_r$ ؛

- مقادیر میدان  $H_1$  و  $H_2$  مربوط به  $M_r \pm 0,5$ .

از موارد بالا، مجذور طولی  $SQ_{||}$  و توزیع میدان متغیر  $SF_S$  یا  $SF_D$  (که برای آن باید مشتق حلقه پسماند رسم شود) را به صورت تعریف شده در استاندارد پایه محاسبه کنید.

#### ۵-۸-۲-۵ اندازه‌گیری حلقه پسماند در جهت عمود

جهت نمونه را طوری قرار دهید که جهت طولی در راستای  $2^\circ \pm 90^\circ$  در جهت میدان قرار گیرد.

گشتاور مغناطیسی  $M$  نمونه را در گستره  $H_{max} \pm$  اندازه‌گیری کنید.

حلقه پسماند را با استفاده از داده گرفته شده در هر  $40 \text{ kA/m}$  ( $500 \text{ oe}$ ) حداکثر و هر  $4 \text{ kA/m}$  ( $50 \text{ oe}$ )

حداکثر در منطقه  $H'_cM$ ، رسم کنید. نتایج، شبیه به حلقه نشان داده شده در شکل ۱۹ است.

از حلقه پسماند به دست آمده، مقادیر کمیت‌های زیر را به دست آورید:

- اشباع مغناطیسی  $M_{max}$ ؛

- پسماند مغناطیسی  $M_r$ ؛

مجذور عمودی  $SQ_{\perp}$  را به صورت تعریف شده در استاندارد پایه محاسبه کنید.

#### ۵-۸-۲-۶ اندازه‌گیری مغناطیس‌زدایی استاتیکی $S_{160}$ در جهت طولی

جهت نمونه را طوری قرار دهید که جهت طولی در راستای موازی با جهت میدان با اختلاف  $2^\circ \pm$  قرار گیرد.

میدان مغناطیسی  $H_{max} +$  را اعمال کنید و سپس آن را به صفر کاهش دهید و مقدار پسماند نمونه  $M_r$  را اندازه بگیرید.

سپس یک میدان مغناطیسی  $160 \text{ kA/m} - (2000 \text{ oe})$  را اعمال کنید و سپس آن را به صفر کاهش دهید و مقدار پسماند نمونه را اندازه گیری کنید.  $M_{-160}^+$  مغناطیس زدایی استاتیکی  $S_{160}$  را به صورتی که در استاندارد پایه تعریف شده است، محاسبه کنید.

### ۵-۸-۳ گزارش آزمون

گزارش باید مقادیر کمیت‌های به دست آمده را ارائه دهد و باید ذکر کند که آیا هر یک از نتایج با الزامات استاندارد پایه تطابق دارد یا نه.

### ۵-۹ شکل موج $U_{i6}$

هدف از انجام این آزمون تعیین میزان اعوجاج شکل موج موجود در شکل موج بازخوانی است زمانی که تحت شرایط مشخصی ضبط شده باشد (به استانداردهای ISO/IEC 7811-6 و ISO/IEC 15457-2 رجوع شود).

### ۵-۹-۱ وسایل

آزمون باید با استفاده از دستگاه مشخص شده در زیربند ۵-۵ برای اندازه‌گیری‌های دامنه بر اساس استاندارد پایه ISO/IEC 7811-6 انجام شود.

### ۵-۹-۲ روش انجام

ترتیب کل اندازه‌گیری‌ها را بر روی تجهیزات یکسان و تحت شرایط یکسان انجام دهید. مرحله خواندن که بر اساس آن اندازه‌گیری‌ها انجام می‌شود باید در همان جهتی انجام شود که ضبط در آن جهت انجام شده است. فقط حرکت لازم برای بازگرداندن کارت به موقعیت شروع آن باید بین مرحله ضبط و مرحله خواندن که بر اساس آن اندازه‌گیری صورت می‌گیرد، انجام شود.

کارت را تحت شرایط مشخص شده در استاندارد پایه، به همراه محدودیت‌های زیر ضبط کنید و بخوانید:

الف- گذر شار در امتداد طول کامل موقعیت شیار ۲ (عرض کامل کارت) را کدگذاری کنید؛

ب- مقدار متوسط دامنه  $U_{A6}$  را مشخص کنید؛

پ- با استفاده از مراحل استاندارد پایه، بزرگترین مقدار  $U_{i6}$  را برای کارت پیدا کنید و آن را به عنوان  $U_{i6}$  ثبت کنید.

### ۵-۹-۳ گزارش آزمون

گزارش باید مقادیر کمیت‌های به دست آمده را ارائه دهد و بیان کند که آیا هر یک از نتایج با الزامات استاندارد پایه تطابق دارد یا نه.

### ۵-۱۰-۱ وادارندگی بالا، اضافه‌نویسی<sup>۱</sup> تراکم بالا

هدف از انجام این آزمون تعیین میزان اعوجاج شکل موج جریان، ناشی از پیشینه ضبط مغناطیسی نوار مغناطیسی است (به استاندارد ISO / IEC 7811-7 رجوع شود).

### ۵-۱۰-۱ وسایل

آزمون باید با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری دامنه، مشخص شده در زیربند ۵-۵، شامل فیلتر و مطابق با استاندارد پایه ISO/IEC 7811-7 انجام شود.

### ۵-۱۰-۲ روش آزمون

با استفاده از جریان  $I_{max}$  تمام طول نوار کارت را در ۲۰ ft/mm بنویسید. با استفاده از یک پنجره Hanning<sup>۲</sup> مقدار  $U_{F17}$  را در ۲۰ ft/mm ضبط کنید.

با استفاده از یک جریان  $I_{min}$  تمام طول نوار کارت را در ۴۰ ft/mm بنویسید. با استفاده از یک پنجره Hanning مقدار  $U_{F18}$  را در ۲۰ ft/mm ضبط کنید.

### ۵-۱۰-۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید مقادیر به دست آمده  $U_{F17}$  و  $U_{F18}$  را ارائه کند و باید ذکر کند که آیا نتایج مطابق با الزامات استاندارد پایه است یا نه.

---

1- Over-write  
2 - Hanning window

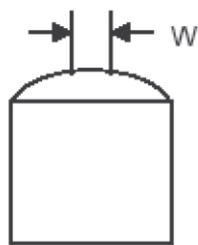
## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### اثر سایش بر روی سرهای آزمون و استفاده از سرهای آزمون مقاوم به سایش

##### الف-۱ اثر سایش بر روی سرهای آزمون

شعاع و ابعاد سرهای آزمون تعریف شده در این استاندارد جهت تنظیم سرهای آزمون برای آزمون انطباق بسیار مهم است. با استفاده بیش از حد در طول زمان، ناحیه "نقطه مسطح" در سرهای آزمون ایجاد می شود. این نقطه مسطح نتایج آزمون را تحت تاثیر قرار می دهد. ضروری است که سر آزمون به طور منظم بسته به تناوب استفاده، حفاظت یا جایگزین شوند. نقطه مسطح به حدی رشد خواهد کرد که نتایج آزمون دیگر برای آزمون مطمئن، قابل اتکا نخواهد بود. کاربران باید سایش نقطه مسطح را پایش کنند و زمانی که ابعاد  $W$  بیش از مقدار پیشنهادی سازنده شد، سر را تعویض کنند. اگر مقدار پیشنهادی برای ابعاد  $W$  داده نشده باشد،  $2\text{ mm}$  به طور پیش فرض برای  $W$  توصیه می شود، همانطور که در شکل الف ۱ نشان داده شده است.



شکل الف ۱- ابعاد  $W$  یک نقطه مسطح

##### الف-۲ سرهای آزمون با پوشش مقاوم در برابر سایش

پوشش های مقاوم در برابر سایش برای معرفی خطاهای اندازه گیری بیش از ۷٪ در هنگام آزمون کارت های ID-1 برای انطباق با استاندارد ISO / IEC 7811-2 و ISO / IEC 7811-6 نشان داده شده است. زمانی که تجهیزات آزمون سرعت بالا، حجم بالا اغلب از پوشش های مقاوم در برابر سایش و/یا سایر ویژگی های غیر سازگار استفاده می کنند، توصیه می شود نتایج حاصل از چنین اندازه گیری هایی تنها به عنوان موردی در نظر گرفته شوند، حتی زمانی که مواد به خوبی شناخته شده است.